19 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

平1-102687 ® 公 開 特 許 公 報 (A)

Solnt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)4月20日

G 06 F 15/70

330

M - 7368 - 5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

円検出装置 **9**発明の名称

> 昭62-258272 ②特 顋

昭62(1987)10月15日 願 ❷出

塺 仍発 明者 盃

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社

内

典 勿発 明 老

日産自動車株式会社

の出願 人 弁理士 土 橋 ・ 皓

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地

蚏

1. 発明の名称

の代 理

円検出装置

2. 特許請求の範囲

画像のエッジ構成点を検出するエッジ検出手段 と、任意点からエッジ構成点までの距離を算出し て距離ヒストグラムを作成するヒストグラム作成 手段と、該ヒストグラム上のピーク点を検出して 円の存在を検出する円存在検出手段とを備える円 検出装置において、横方向のエッジ強度および縦 方向のエッジ強度をそれぞれ算出するエッジ強度 算出手段と、該算出されたエッジ強度に基づき エッジ構成点の法線方向を算出する法線方向算出 手段と、当該エッジ構成点と前記任意点とを結ぶ 直線の方向を算出する方向性算出手段と、胰直線 の方向が前記法線方向を基準とする所定範囲内の 値であることを判別したときに当該エッジ構成点 を抽出してヒストグラム作成手段に出力する比較 判定手段とを備えることを特徴とする円検出装 置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、対象風景から円の存在を検出する円 検出装置に係り、特に円検出の高速化、信頼性向 上を実現する技術に関する。

(従来の技術)

円検出装置としては従来例えば第9図に示すよ うなものがある。同図において、1はカメラ等の 画像入力部、2は入力画像からエッジ構成点を検 出するエッジ検出部、3は該エッジ構成点を奪き 込む画像メモリ、4はエッジ画像中において円検 出領域を設定するマスク設定部、5は該マスクの 中心点(この中心点はエッジ画像中の任意の点に 設定される)からエッジ構成点までの距離を算出 する距離算出部、6は該距離値に基づきエッジ機 成点のヒストグラムを作成する距離ヒストグラム 作成部、7は該ヒストグラム上のピーク点を検出 するピーク検出部、8は骸ピーク点の頻度が所定 閥値を越えるか否かにより前配任意点が円の中心 点か否かを判別し、ピーク点の頻度が所定閾値を

越えたときには当該マスク中心点を円の中心点と して出力する円中心検出部、9は検出された円の データ(中心点、半径等)を出力するデータ出力 都である。

(実施例)

以下級付団面に基づいて本発明の実施例を説明する。

第1図は本発明に係る円検出装置の一例を示す ものである。

(発明が解決しようとする問題点)

そこで、本発明の目的は、円検出の信頼性を高 めるとともに円検出処理の高速化を可能とするこ とにある。

(問題点を解決するための手段)

前記目的を達成して従来技術の問題点を解決するため、本発明に係る円検出装置は、画像のエッ

まず構成を説明すると、第1図において11は カメラ等の画像入力部、12は入力画像から横方 向のエッジ強度を算出して画像メモリ13に書き 込む横方向エッジ強度算出部、14は入力画像か ら縦方向のエッジ強度を算出して画像メモリ 15に書き込む経方向エッジ強度算出部、16は これらのデータから入力画像全体のエッジ構成点 を検出して画像メモリ17に書き込むエッジ検出 部、18は被検出円の最大半径ェルに応じて (2rn+1)×(2rn+1)の正方形状マス クを設定するマスク設定部、19はエッジ画像か ら後述するような特定のエッジ構成点を抽出する エッジ点抽出部、20はマスク内の各エッジ構成 点について法線方向を算出する法線方向算出部、 2.1はマスク中心点と各エッジ構成点とを結ぶ直 線の方向を算出する方向性算出部、22は該算出 された直線方向と前記法線方向とを比較して、当 鉄直線の方向が法線方向を基準とする所定閥値内 にあるときに当該エッジ構成点を抽出して後段へ 出力する比較判定部、23はマスク中心点から抽

特閒平1~102687 (3)

出されたエッジ構成点までの距離を算出する距離 算出部、24は該算出された距離に従ってヒスト グラムを作成するヒストグラム作成部、25は該 ヒストグラム上のピーク点を検出するピーク検出 部、26は該ピーク点の頻度が所定関値を越える か否かを判別し、該関値を越えるときにはそのと きのマスク中心点を円中心として抽出する円中心 検出部、27は該検出された円中心点、ピーク点 の距離(円半径)、ピーク点頻度等を出力する データ出力部である。

以下、本裝置の作動について説明する。全体の 処理フローは第2 図に示す通りである。

まず画像入力部11から入力した画像に対し、 横方向エッジ強度算出部12、縦方向エッジ強 度算出部14において、それぞれ第3図に示す Δx, Δyなるオペレータを作用させ、各方向の エッジ強度を算出して画像メモリ13, 15へス トアする(S-1), (S-2)。

次にエッジ検出部16において、横方向エッジ 強度、縦方向エッジ強度の少なくとも一方が所定

6 図に示すように

$$\phi(x, y) = tan^{-1} \frac{V(x, y)}{H(x, y)}$$

で与えられる。H(x, y) = 0の時は $\phi(x, y) = 90°(鉛直エッジ)、<math>V(x, y) = 0$ の時は $\phi(x, y) = 0°(水平エッジ)$ となる。

他方、方向性算出部 2 1 は、マスク中心点 (i,j) とエッジ構成点 (x,y) を結ぶ直線 の方向 ω (x,y) を算出する (S-9)。この 方向 ω (x,y) は、第7 図に示すように

$$\omega (x, y) = tan^{-t} \left| \frac{y-j}{x-i} \right|$$

によって与える。

次に比較判定部22は、このようにして算出した法線方向 ϕ (x, y)と直線方向 ω (x, y)とを比較し(S-10)、

 ω (x, y) $-\delta$ **S** ϕ (x, y) **S** ω (x, y) + δ ω (x, y) + δ ω (x, y) は、マスク中心点(i, j) を中心とする円弧上の点として当該エッジ構成点(x, y) を抽出する。こ

関値 T を越えるときに 当該画案をエッジ構成点として抽出し"1"の値をもたせ、関値 T 以下のときには"0"の値をもたせて画像メモリ17にストアする(S-3)。尚、画像メモリ13、15、17にストアされた画像をそれぞれH(x,y),V(x,y),A(x,y)としておく。以上のエッジ検出処理の一例を第5 図に例示する。

次に、これらのエッジデータに基づいて半径 ri, ra, ra, ···ra の円を検出するための処理に移る。まず、マスク設定部18において第 4図に示すように縦2ra +1。横2ra +1の 正方形状マスクを設定する(S-4)。マスクの 大きさ2ra +1は検出しようとする最大の円 (半径ra)がマスク内に入る大きさである。

次に、法線方向算出部 20 は、マスク内のエッジ点(A(x,y)=1 である点)について、前配 画像 H(x,y), V(x,y) に基づいて法線方向 $\phi(x,y)$ を算出する(S-6)~(S-8)。この法線方向 $\phi(x,y)$ は、第

れ以外のエッジ構成点は円弧上の点ではないから抽出は行なわない。第7図に示す場合、エッジ点 (x,,y,)は円弧上の点として抽出され、エッジ点(x,,y,)は円弧上の点ではないとして抽出されない。

さて、これ以後の処理は従来装置と同様である が本装置の場合は、比較判定部22で抽出された エッジ構成点についてのみ行なう。

まず、距離算出部23は、抽出されたエッジ 構成点(x,y)とマスク中心点(i,j)の 距離(ユークリッド距離)dを算出する(S-11)。

 $d = \sqrt{(x-i)^2 + (y-j)^2}$

である。この処理は、比較判定部22で抽出され たすべてのエッジ構成点について行なう。

次に、距離ヒストグラム作成部24は、算出された距離値に基づいてヒストグラムを作成し(S-5), (S-12)、ピーク検出部25において鉄ヒストグラム上のピーク点を検出し、 該ピーク点の距離値Vα頻度Καを算出する

特別平1-102687 (4)

 $(S-13) \sim (S-16)$.

そして、円中心検出部26において、頻度Kαを所定の関値KτHと比較し(S-17)、Kα≥KτHの時にはマスク中心点(i, j)を中心とする半径rαの円が存在すると判定し、データ出力部27を介してマスク中心点(円中心点)、ピーク点の距離値(円半径)、ピーク点の頻度等のデータを表示する(S-18)。尚、Kα<KτHの時には円は存在しないと判定する。

以上の処理を、エッジ画像A(x,y)においてマスクを移動させながらすべての点について行なうことにより円の検出が終了する。

尚、この実施例ではエッジ面像A(x,y)上に正方形のマスクを設定して円検出を行なったが、本発明はテンプレートマッチングによる円検出にも適用可能である。例えば第8図に示すようにテンプレート40上に複数のエッジ点列が乗っている場合、従来装置では高いマッチ度が得られるためにテンプレート40の中心点(i,j)を円中心点として検出する可能性があったが、本発

プロック図、第2図は本発明に係る円検出装置の作動例を示すフローチャート、第3図はマスクの一例を示す図、第4図はマスクの設定方法を例示する図、第5図は本発明装置におけるエッジ検出の一例を示す図、第6図は法線方向の算出例を示す図、第7図は特定エッジ点の抽出例を示す図、第8図は本発明装置における他の処理方法を例示する図、第9図は従来の円検出装置の示すブロック図、第10図は従来の円検出装置における円検出例を示す図である。

- 12…横方向エッジ強度算出部
- 14…縦方向エッジ強度算出部
- 16…エッジ検出部
- 19…特定エッジ点抽出部
- 20…法線方向検出部
- 2 1 … 方向性検出部
- 24…距離ヒストグラム作成部
- 25…ピーク検出部
- 26…円中心検出部

明によれば、エッジ点の法線方向を検出して円弧 上のエッジ点でないものは排除してヒストグラム 作成を行なうため、誤検出を防止できることにな る。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明に係る円検出装置によれば、エッジ構成点の法線方向およびまなが動像上の任意の点とを結ぶを直線方向の各値を算出し、該直線方向の各値を基準とする所定値内にあるときにのみながの値を基準とする所定値内にあるともに数方向との関係があるとともに処理速度が高速化するという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る円検出装置の一例を示す

第3回

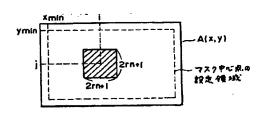
ı	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

i横方のエッジ強度集出用マスクA×

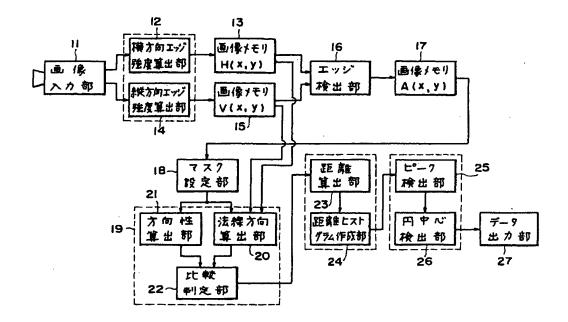
-1	0	ı
-2	0	2
-1	0	1

A従方向エッジ 独産 算出用マスクAY

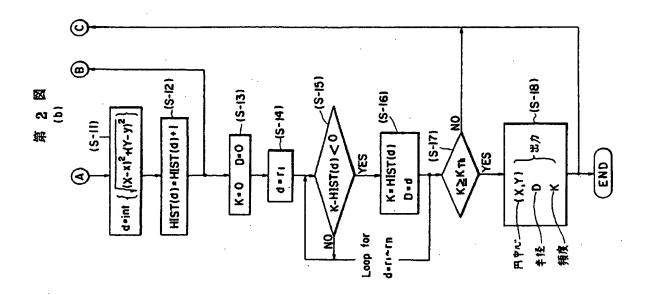
第 4 図



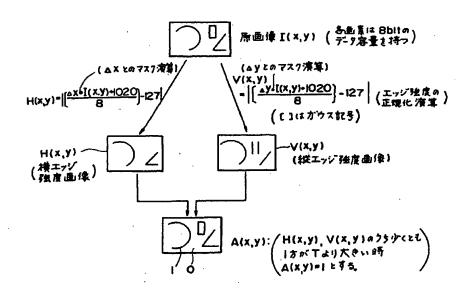
第 1 図



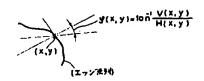
第 2 図 (0) (START) ま従エッジ独産事出→V(x,Y)生成 → 画像 メモイ目Bにストア ~(S-I) 横エッジ発度算出 →H(x,y)生成 → 画像/モリムにストア ~(S-2) エッジ点接出 --- A(x, y)生成--- 曲様が付にストナー-(S-3) X = Xmin, Y = ymin (X,Y1:マスクヤル皮標 ヒストクツム用 雪とかり HIST(n)クリア ~(S-5) x=X-rn, y=Y-rn A(x,y)-1 Loop for (Ş-8) YES X= x min ~ xmqx Y=Ymin ~ ymox \$(x,y)=tan=1{V(x,y)/H(x,y)} Loop for $w(x, y) = tan^{-1} \left| \frac{Y - Y}{X - x} \right| - (S - 9)$ x= X-rn~X+rn ya Y-rn~Y+rn | y(x,y)-w(x,y)|≤ & YES

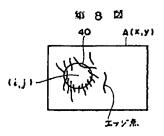


第 5 図

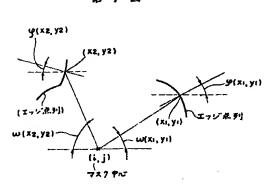


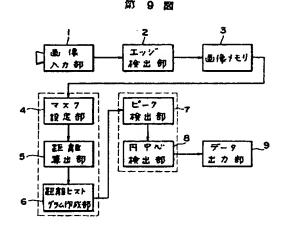
邓 6 図





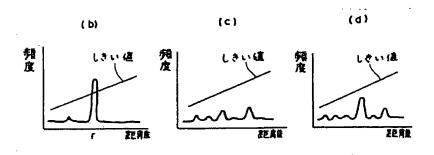
第7图





第10 図 (a)

A B A(x,y)



X3